昆山国显光电有限公司

5.99FHD+产品应用手册 (RM69297)

文件编号: GAM-N-051 版本号: A0

起	草:	
审	核:	
审	批:	

机密等级: 受控状态:

发布日期:

执行日期:

文件修订履历表

序次	修订内容摘要	版本号	起草/日期	审核/日期	审批/日期
1	新版制定	A0			
2					

1 目的

定义 5.99FHD+产品的应用说明。

2 范围

本产品应用手册适用于昆山国显光电有限公司 5.99FHD+产品。

3 定义与职责说明

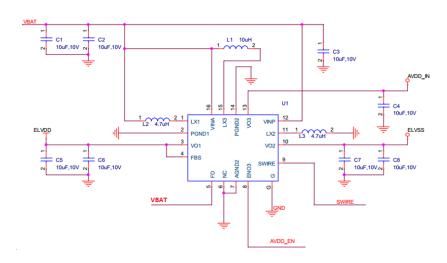
- 3.1. 开发中心电路设计部对本产品应用手册具有制定和修改的权限;
- 3.2. 开发中心开发管理部配合开发中心电路设计部对本产品应用手册进行修订;
- 3.3. 开发中心模组设计部配合开发中心电路设计部对本产品应用手册进行修订;
- 3.4. 营销中心 FAE 部根据实际项目需求将本产品应用手册提供给客户,供客户设计参考。

4 内容

- 4.1 模组电性规格部分
- 4.1.1 模组规格概况

	Feature	Spec	Remark
	Screen Size (inch)	5. 99	
	Display Mode	AMOLED	
	Resolution(dot)	1080 (W) x 2160 (H)	SPR
	Active Area(mm)	68. 042 (W) x 136. 08 (H)	
Display Spec	Pixel Pitch (um)	63.00(W) x 63.00 (H)	
	Pixel Configuration	V-Style4	
	Technology Type	LTPS	
	Color Depth	16.7M	
	Interface	MIPI 4LANE	
Mechanical	With TP/Without TP	With TP	
Characteristic s	Module Outline Dimension(mm)	72. 50 (W) x148. 08 (H) x1. 35 (D)	Including Cover lens
	Driver IC(Type)	RM69297	
Electronic	Touch IC(Type)	mXT640U	
	Power IC(Type)	NC	

- 4.1.2 模组外供 DC-DC Power Design Guide
- 4.1.2.1 模组采用三路输出 Power IC 提供 ELVDD、ELVSS 和 AVDD, 目前 FHD 项目中按照优先次序建议使用 TPS65651A/ RT4722 两颗 Power IC,推荐应用电路图和元件如下。



- 4.1.2.2 注意事项:
- 4.1.2.2.1 电纹波要求: Power IC输入电源 VBAT 纹波要求小于 2%,输出电源 ELVDD ripple ≤ ELVDD*0.8%; ELVSS ripple ≤ ELVSS*1%; AVDD ripple ≤ AVDD*1%。
- 4.1.2.2.2 Power IC FD PIN 建议连接 Vbat 使用:可保证模组 Display On 前及 Display off 后将屏体残余电荷完全泄放,避免出现开关机或唤醒时出现闪屏问题。
- 4.1.2.2.3 针对终端应用方案,建议将 Power IC 设计在系统主板上,主要基于以下考虑:

PCB 板上散热要远优于 FPC, 有利于提升 Power IC 效率 (可由 70+%提高到 80+%~90%);

Power IC 在 FPC 上,会使 Power IC 贴合位置屏体长时间工作在高温下,造成局部 OLED 老化速度加快,出现局部偏色或色斑;

Power IC在FPC上,对连接器电性要求更高;

Power IC 在 FPC 上, FPC 无法仿照 PCB 工艺在 Power IC 位置增加屏蔽罩等措施,不利于整体电磁干扰管控。

- 4.1.2.2.4 终端应用中,客户端系统平台开机和唤醒需要做 50ms 以上插黑画面处理,以避免开机可能的显示异常问题。
- 4.1.3 电磁干扰相关建议

综合考量天线等模块,将 Power IC 打件在主板上,而非 FPC 上,并加屏蔽罩处理;

天线同轴线尽量避免与模组 FPC 或转接 FPC 交叉布局:

若方案采用转接 FPC 将模组与主板连接,转接 FPC 双面进行覆盖屏蔽膜处理,同时在 FPC 适当位置增加漏铜接地点与系统地,组装时与系统地相连。

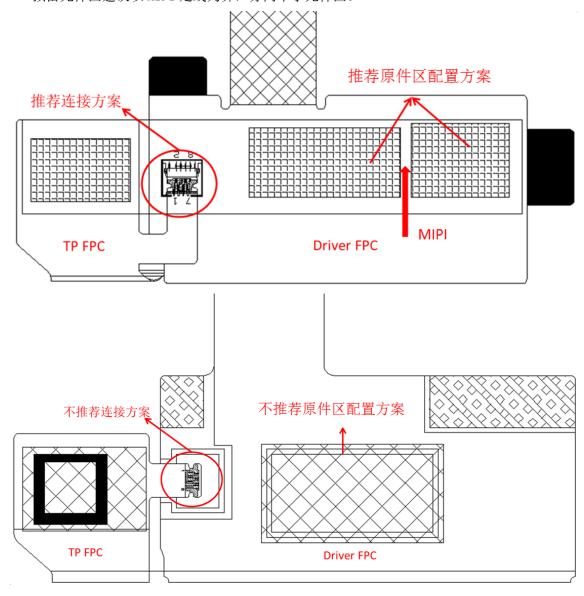


- 4.1.4 模组 Driver FPC 相关建议
- 4.1.4.1 FPC Connector PIN 注意事项及建议:

OTPV PIN 在客户主板的连接状态建议 NC,以避免待机时漏电;

与 TP 相连方式建议采用如下图示上下直连方案,而非左右连接方向;

预留元件区建议以 MIPI 走线为界,分两个子元件区。



4.1.4.2 Connector端 MIPI 信号顺序: FHD 产品支持以下 16 种排序方式,建议在项目开案时,MIPI 顺序选择其中的一种,以尽量减少 MIPI 对之间的交叉。

PSWAP	DSWAP[2:0]	HSSI_									
PSWAP	DSWAF[2.0]	D3_P	D3_N	D0_P	D0_N	CLK_P	CLK_N	D1_P	D1_N	D2_P	D2_N
	000	D3P	D3N	D0P	DON	CLKP	CLKN	D1P	D1N	D2P	D2N
	001	D3P	D3N	D2P	D2N	CLKP	CLKN	D1P	D1N	D0P	D0N
	010	D2P	D2N	D1P	D1N	CLKP	CLKN	D0P	D0N	D3P	D3N
0	011	D0P	D0N	D1P	D1N	CLKP	CLKN	D2P	D2N	D3P	D3N
	100	D3P	D3N	D1P	D1N	CLKP	CLKN	D0P	D0N	D2P	D2N
	101	D3P	D3N	D1P	D1N	CLKP	CLKN	D2P	D2N	D0P	D0N
	110	D2P	D2N	D0P	D0N	CLKP	CLKN	D1P	D1N	D3P	D3N

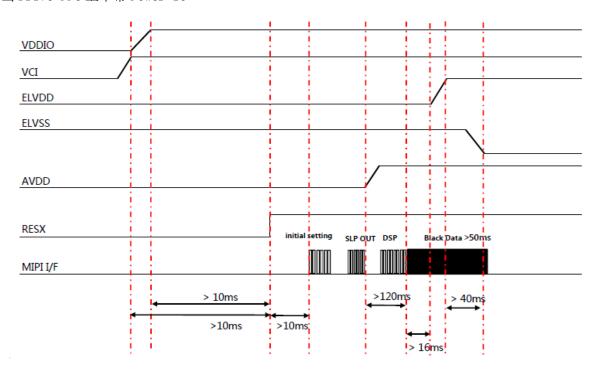
5.99FHD+产品应用手册 昆山国显光电有限公司 文件编号: GAM-N-051 版本号: A0

	111	D0P	D0N	D2P	D2N	CLKP	CLKN	D1P	D1N	D3P	D3N
	000	D3N	D3P	D0N	D0P	CLKN	CLKP	D1N	D1P	D2N	D2P
	001	D3N	D3P	D2N	D2P	CLKN	CLKP	D1N	D1P	DON	D0P
	010	D2N	D2P	D1N	D1P	CLKN	CLKP	D0N	D0P	D3N	D3P
1	011	D0N	D0P	D1N	D1P	CLKN	CLKP	D2N	D2P	D3N	D3P
'	100	D3N	D3P	D1N	D1P	CLKN	CLKP	D0N	D0P	D2N	D2P
	101	D3N	D3P	D1N	D1P	CLKN	CLKP	D2N	D2P	D0N	D0P
	110	D2N	D2P	DON	D0P	CLKN	CLKP	D1N	D1P	D3N	D3P
	111	D0N	D0P	D2N	D2P	CLKN	CLKP	D1N	D1P	D3N	D3P

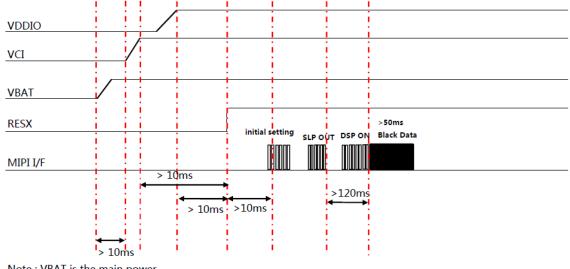
4.1.5 模组上下电时序

4.1.5.1 Display on Sequence

当 Drive FPC 上不带 Power IC



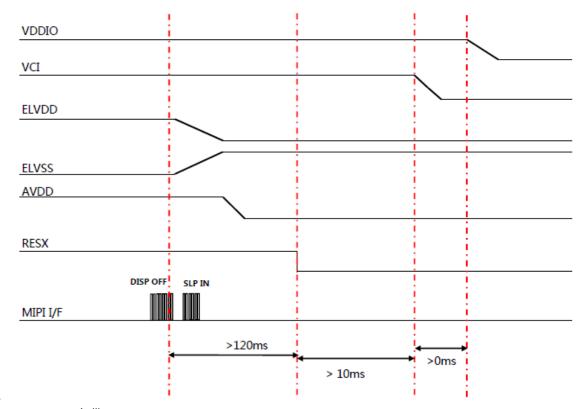
当 Drive FPC 上带 Power IC



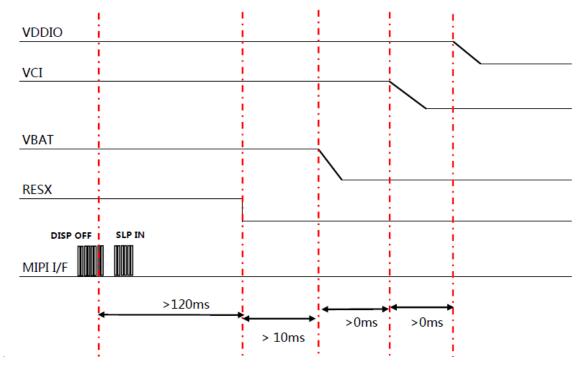
Note: VBAT is the main power.

4.1.5.2 Display Off Sequence

➤ 当 Drive FPC 上不带 Power IC



➤ 当 Drive FPC 上帶 Power IC



Note:

客户端系统平台开机和唤醒需要做 50ms 以上插黑画面处理,以避免开机可能的显示异常问题;上电时序中,建议 VCI 略早于 VDDI0 上电。

4.1.6 常用指令

4.1.6.1 亮度调节 (类 LCD 背光调节)

Use "command 5100h, data xxh" to adjust the Manual Brightness value of the display: In principle relationship is that 00h value means the lowest brightness and FFh value means the highest brightness.

			ite Disp				WRDI	SBV					
Inst/Para	R/ W		dress	D15	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HE
parameter 1			5100h		DBV15	DBV14	DBV13	DBV12	DBV11	DBV10	DBV9	DBV8	F
parameter 2	W	_	5101h	x				DBV4					F
Description	The An 8-b 12-	e chip d defa	can be sult is 8-but	elect it mo DBV[DBV	ted 8-bit de. (ple 15:8] (Pi [11:8] (i nt of ligh	or 12-bi ase refe aramete Paramet	t brightn r to user r 1)	FFh values values (0	e by us CMD2 p	ing DBV age-digi	_SEL t		55.
	_			lloro				d for two	ina				
Restriction	The	e displ	State	ıs			omman	Defa Para	ult Value meter 1	Parar	meter 2	2	
Restriction	Th	e displ	State	ıs er Or	Seque		omman	Defa Para FFh	ult Value	Parar FFh	meter 2	2	
	Th	e displ	Statu	ıs er Or Rese	Seque		omman	Defa Para FFh FFh	ult Value	FFh FFh	meter 2	2	
	The	e displ	Statu	ıs er Or	Seque		omman	Defa Para FFh	ult Value	Parar FFh	meter 2	2	

4.1.6.2 Read Module ID

	T.,	page s	witch	DATA	DESCRIPTION
	Instruction	Other	MIPI	DATA	DESCRIPTION
ID	CMD Mode Switch	FE00	FEH	0x00	切换page
回读		DAOO	DAH		回读ID1
	ID number	DB00	DBH		回读ID2
		DC00	DCH		回读ID3

RDCTRLD1 (DA00h): Read Control ID1

DA00H						R	DCTRL	D1					
Inst/Para	R/W		ress Other	D15-8	D7	D6	D 5	D4	D 3	D2	D1	D0	HEX
RDCTRLD1	R	DAh	DA00h	х		ID1							00
Description	This	read	ead byte identifies Module's manufacture ID										

RDCTRLD2 (DB00h): Read Control ID2

DB00h						R	DCTRL	D1					
Inst/Para	R/W		ress Other	D15-8	D7	D6	D 5	D4	D 3	D2	D1	D0	HEX
RDCTRLD2	R	DBh	DB00h	x		ID2							00
Description	This	read	byte ide	ntifies M	lodule /	driver \	ersion/	ID					-

RDCTRLD3 (DC00h): Read Control ID3

DC00h						R	DCTRL	D1					
Inst/Para	R/W		Iress Other	D15-8	D7	D6	D 5	D4	D 3	D2	D1	D0	HEX
RDCTRLD3	R		DC00h	Х	ID3						00		
Description	This	read	byte ide	byte identifies Module / driver ID									,

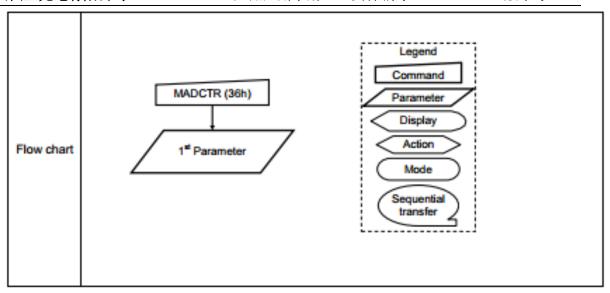
		Default Value	
	Status	After MTP	Before MTP
	Power On Sequence	MTP Value	00h
	SW Reset	MTP Value	00h
Default	HW Reset	MTP Value	00h
Flow Chart	Send Parameter RDCTRLD[7:0]		Legend Command Parameter Display Action Mode Sequential transfer

4.1.6.3 左右镜像设置

This command defines the scan direction of Source and Gate Driver. This command makes no change on the other driver status.

(3600h) MADCTR: Set Address Mode

,		JUL 7-10	aress N		DCTR	(Scan	Directi	on Co	ntrol)				
Inst/Para	R/W		ress	D15-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	HEX
		MIPI	Other										
Description	D5 D4 D3 D2 D1 D0	Rei Rei Rei Rei Rei Rei Rei	n the oth nbol served served served served served served served	s the sca er driver: Descrii Horizon	status. otion) DO		0 '0'	= Nom = Flipp		olay	D0 mand m	nakes
Restriction	BIL D3	is not a	10016301	e while re	solullo	n iş Fn	D SPR	•					
Default			Status Power C SW Res HW Res		nce		O(efault \ the o Char the o					



4.1.7 可选功能指令

4.1.7.1 Write CE3 (Temperature)

This command is used to set the different temperature.

WRTMR (6200h) : Write CE3 (temper)													
6200h	WRTMR (Write_Temper_Level)												
Inst/Para	R/W	Add MIPI	dress Other	D15-8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX
WRTMR	w	62h	6200h	х	TEMPER _EN	TEMPER _LEVEL [6]	TEMPER _LEVEL [5]		TEMPER _LEVEL [3]	TEMPER _LEVEL [2]	TEMPER _LEVEL [1]	TEMPER _LEVEL [0]	00
			and is u	sed to			eters for	CE (co	(color enhance)				
	В				Descri				Valu	ie lisable			
	TEMPER_EN				Temperature enable				1 : enable				
Description	TEMPER_LEVEL[6:0]				Temperature Set			0~6	0~64 setting				
Restriction	-												
Flow Chart	Legend Command Parameter Display Action Mode Sequential transfer												

4.1.7.2 Write CE6 (Decrease gamut mode)

4.1.8 ESD Design Guide

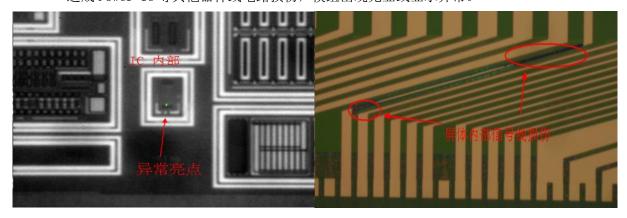
4.1.8.1 ESD 对模组的危害

造成 Driver IC 内部损伤,模组出现无显或显示异常;

造成 TP IC 内部损伤,模组出现 TP 触控功能异常;

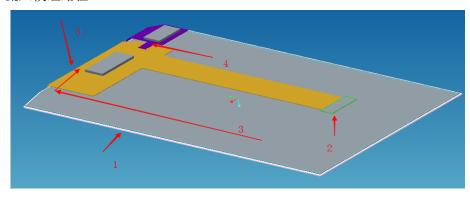
造成 Panel 信号线损伤,模组出现无显或显示异常;

造成 Power IC 等其他器件或电路损伤,模组出现无显或显示异常。



4.1.8.2 ESD 防护

4.1.8.2.1 ESD 流入模组路径



通过模组边缘引入 Panel ESD Damage;

Driver FPC Connector:

与主板的 shoot 或其他路径流入 ESD 造成 Driver FPC 元器件放电,产生 ESD Damage;

TP FPC Connector;

整机中 Driver IC 附件 Hole 或其他路径引入的 IC ESD Damage。

4.1.8.2.2 ESD Protection Level

Model	Level	备注
CDM	±4kV	Module: R = 330ohm / C = 150 pF
Air ESD	±8KV	Module Face Up
Machine Mode	200V	Driver IC : R = 0 ohm / C = 200 pF

4.1.8.2.3 防护措施

4.1.8.2.3.1 接口输入信号增加适当的保护元件:

电路	建议	备注		
HSSI	Common Mode ESD Filter	考虑 SI 特性		

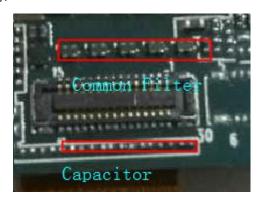
昆山国显光电有限公司

5.99FHD+产品应用手册

文件编号: GAM-N-051 版本号: A0

Signal	TVS Diode or Bead	考虑 SI 特性
Power	Capacitance	

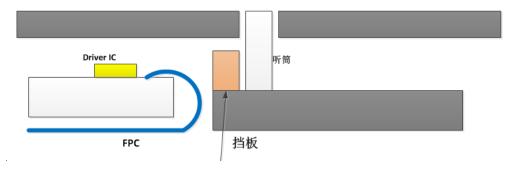
客户应用实例:



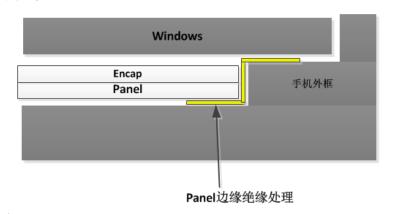
4.1.8.2.3.2 FPC 或转接的表面开窗漏出可接地 Pad,并将 Pad 与主板上的系统地稳定连接:



4.1.8.2.3.3 听筒位置尽量与 Driver IC 保持间距,同时建议听筒与 Driver IC 之间增加垂直挡板,如下示意图:



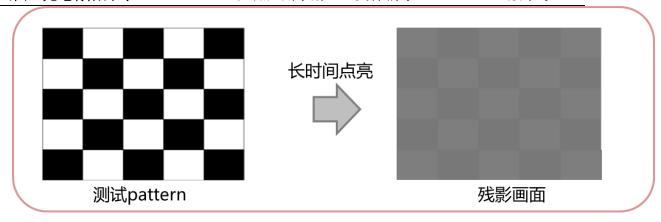
4.1.8.2.3.4 为防止 ESD 从 Panel 边缘进入,建议如下示意,在 Module 周边做绝缘处理,同时手机外边框 采用接地金属边框。



4.2 模组光学规格部分

4.2.1 残影

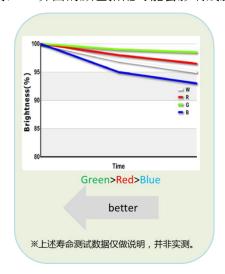
即影像残留(Image Sticking),是在屏幕上长时间显示同一副画面时,改变显示画面后,屏幕上仍然可以看到前面图像残像的现象。



残影产生的原理

OLED 由 R/G/B 三种颜色组合而成;

由于有机发光材料的降解,OLED 的亮度会伴随着点亮时间的增加而持续衰减;由于 R/G/B 三原色寿命不同,UI 界面的颜色搭配可能会影响残影的产生。

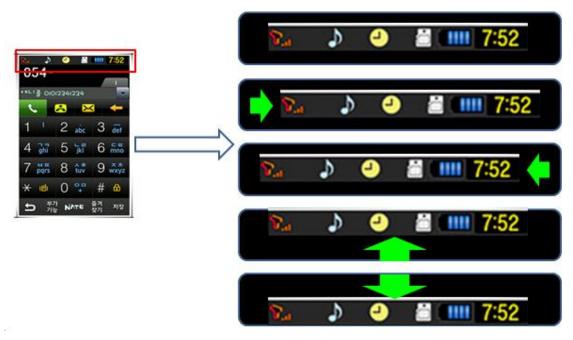


4.2.2 UI Design Guide

4.2.2.1 UI 界面颜色控制:



4.2.2.2 UI 界面图标控制



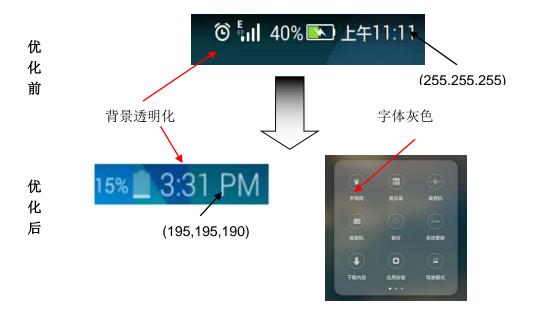
对于经常需要固定显示的图标,可通过 UI 设计在不同的时刻相应的改变其固定的位置(可稍微进行移动),可以避免在同一固定位置处产生残影现象。

- 4.2.2.3 图标交界界面平滑过渡,避免高对比度形成残影-----①。
- 4.2.2.4 深色 UI 背景和黄色图标。----②



4.2.2.5 浏览界面和图标透明显示处理。





4.2.2.6 图标自动隐藏: UI 界面图标不用时,可设置为自动隐藏,避免长时间存在形成残影。

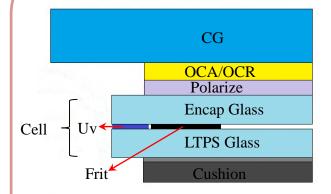


上图为菜单栏图标长时间点亮在屏体下端形成残影。

- 4.3 模组机构规格部分
- 4.3.1 结构差异性(AMOLED(柔性固定曲面&硬屏) &TFT LCD)



AMOLED 厚度堆叠

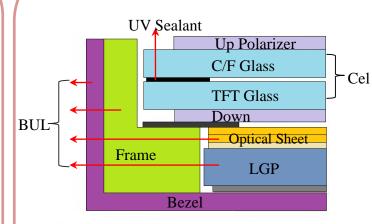


主要构件:

CG+OCA/OCR(光学胶)+Polarizer+Cell +Cushion(或其他部材)

-Frit:在显示屏体边缘侧,因采用frit材料封装, 此材料模量大存在脆断风险高;

TFT LCD 厚度堆叠

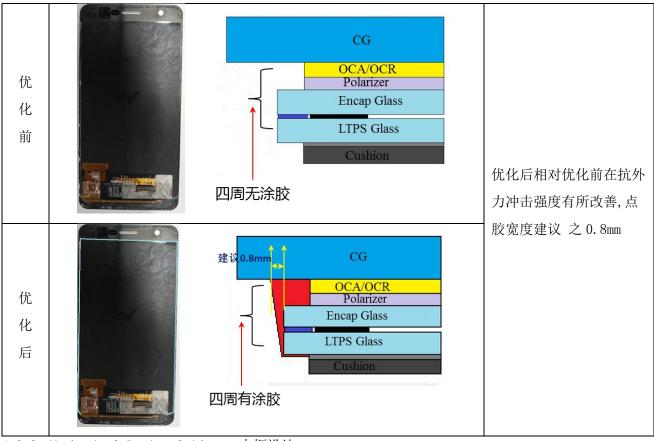


主要构件:

Polarizer+Cell+Polarizer +BLU(optical/LGP/Frame/Bezel)

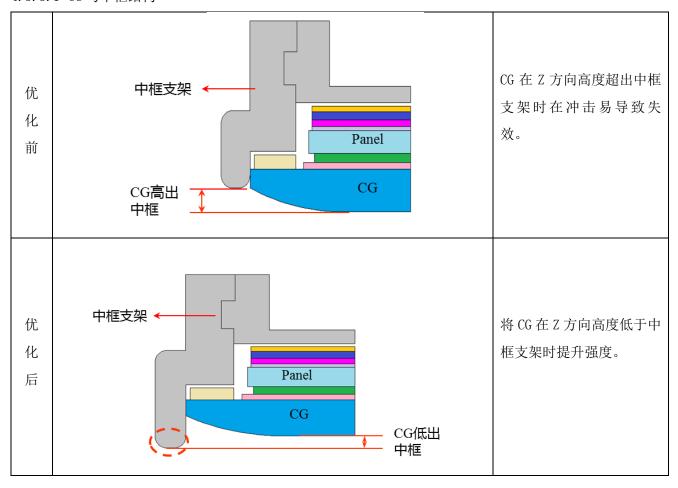
-uv sealant:在显示屏体边缘侧,在其结构上采用其他辅助件增加强度如(Bezel&Frame)并且 Uv sealant 模量小不易脆断;

4.3.2 Mechanical Design Guide —— 屏体与 Window 结构

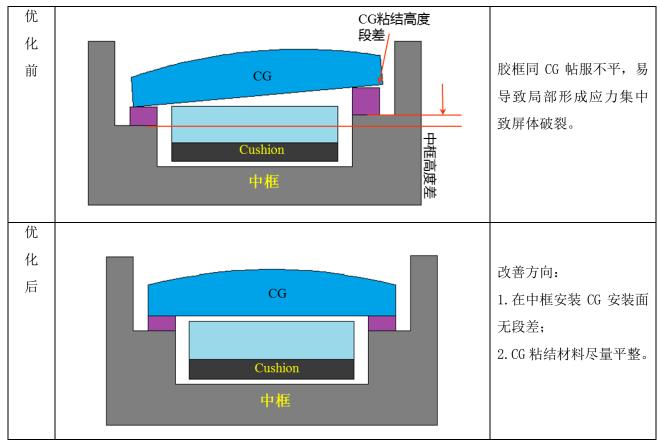


4.3.3 Mechanical Design Guide——中框设计

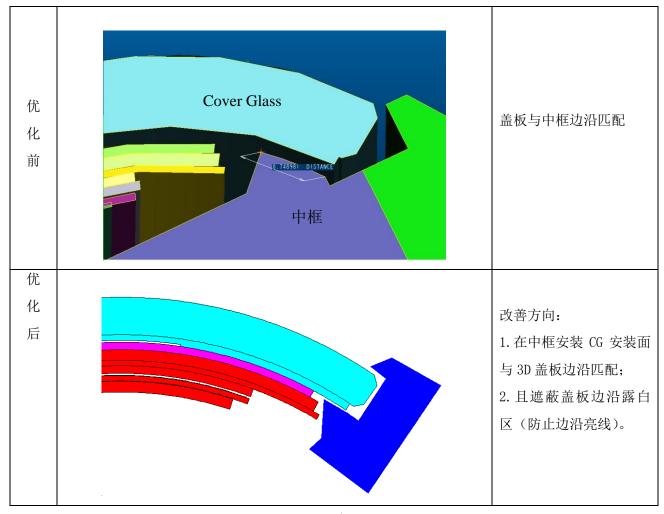
4.3.3.1 CG 与中框结构



4.3.3.2 CG 与中框结构



4.3.3.3 CG 与中框结构

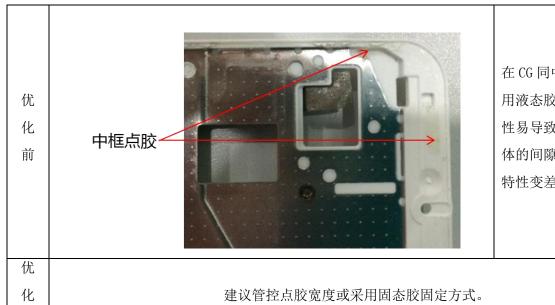


4.3.3.4 中框抗变形结构



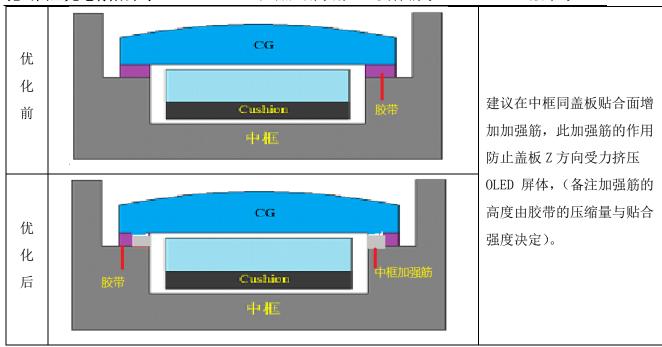
中框内部结构如出现大量的通孔 结构或组合件,在强度或抗变形 方面会变差,改善措施尽量减少 孔的面积,多采用一体成型件结 构。

4.3.3.5 中框与模组组立结构



在 CG 同中框组立过程采 用液态胶粘合,因胶流动 性易导致胶填充中框与屏 体的间隙使屏体在抗冲击 特性变差。

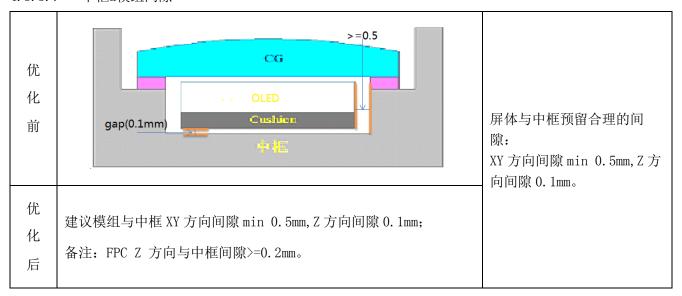
化后



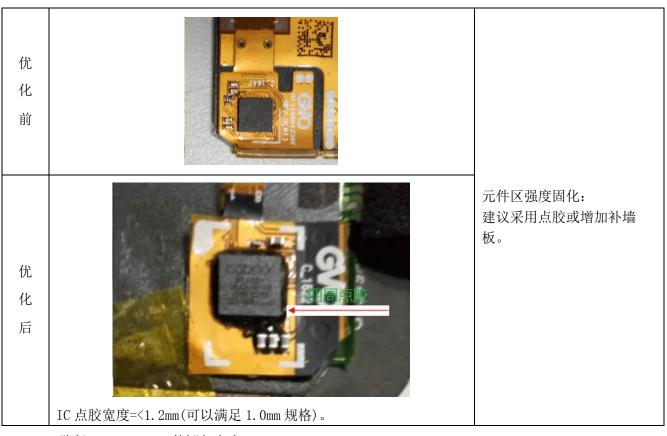
4.3.3.6 中框底面结构



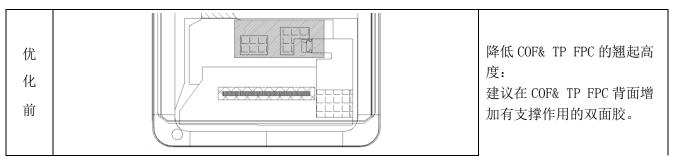
4. 3. 3. 7 中框&模组间隙

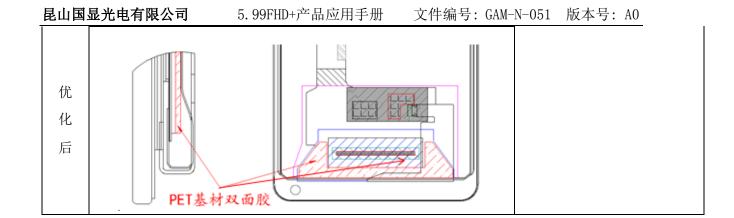


4.3.3.8 增加元器件固定强度



4.3.3.9 降低 COF& TP FPC 的翘起高度





5 相关文件

序号	文件名称	文件编号	主导部门
1	_	_	-
2			

6 相关表单

序号	表单名称	表单编号	保存期限	保存部门	收集频率	收集部门
1	_	_	-	_	-	-
2						

7 附件

序号	附件名称	附件编号
1	-	-
2		